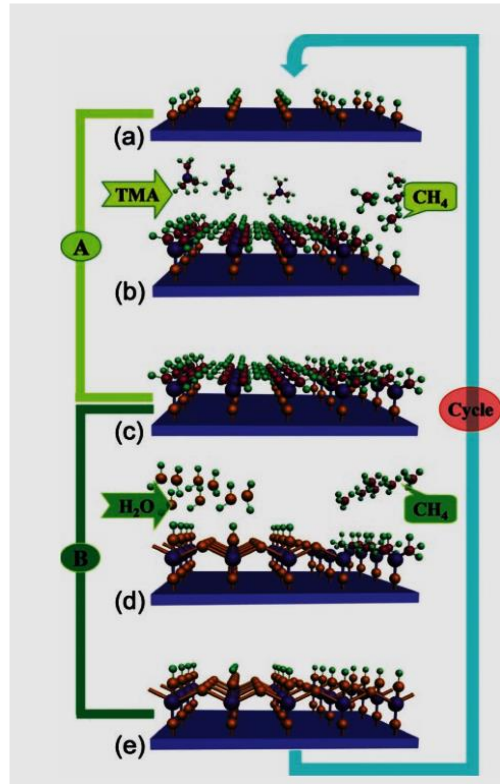
MINI DESKTOP ALD

小巧紧凑 功能强大

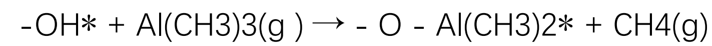
粉体&3D原子层镀膜系统

厦门韫茂科技有限公司

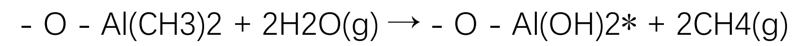
ALD原理



半反应A:



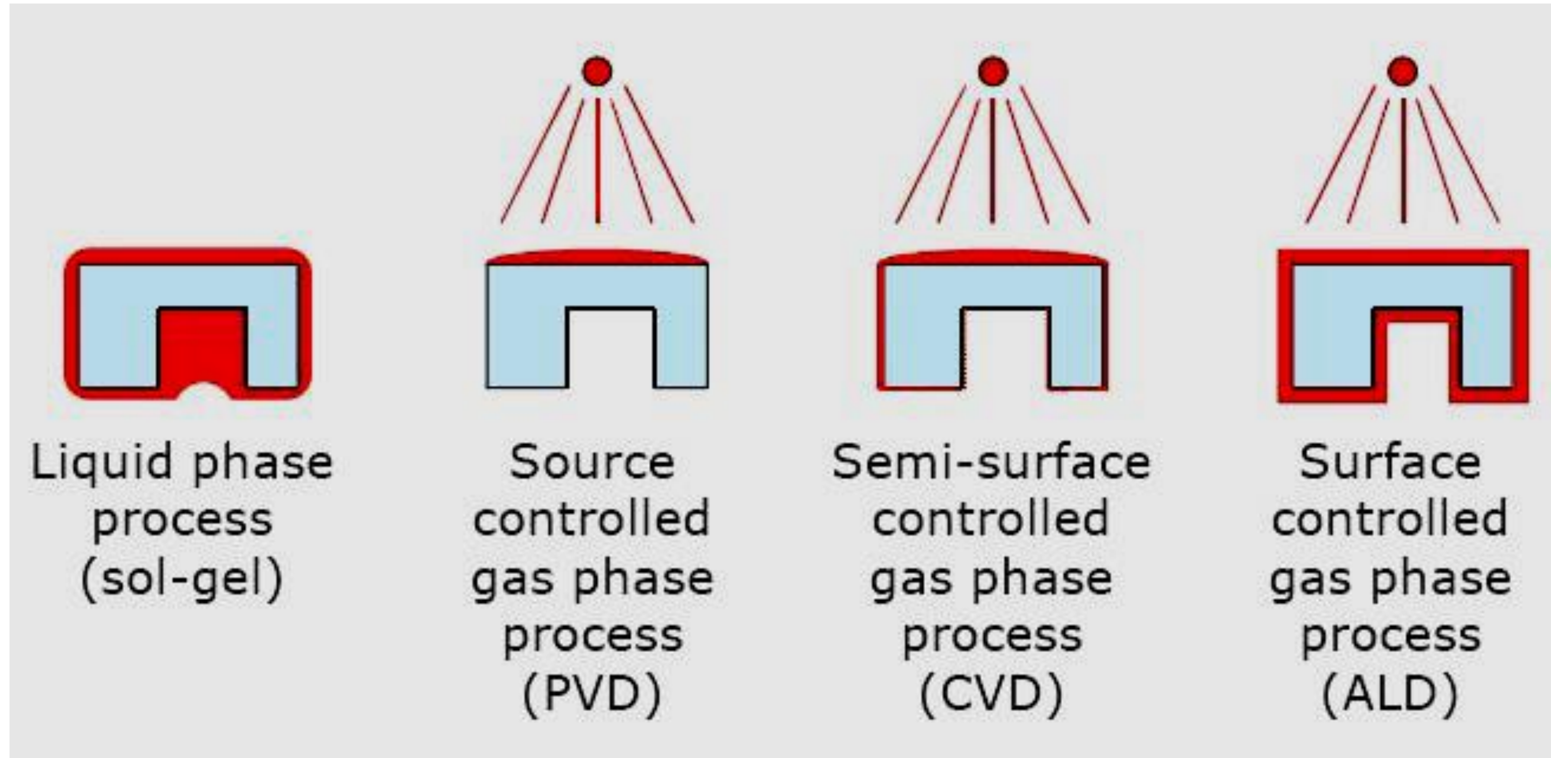
半反应B:



总反应:

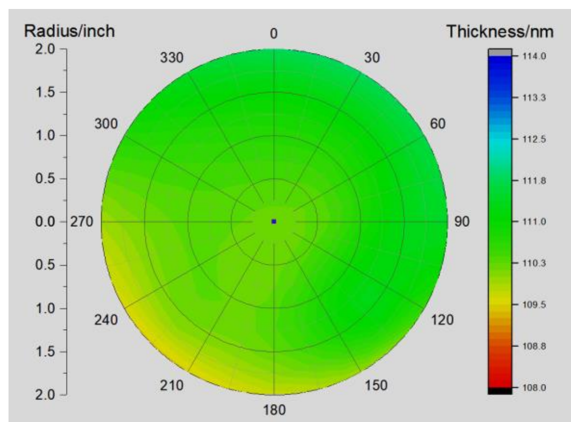
ALD技术将气相前驱体脉冲交替（A-B）通入反应室, 在基板上发生化学反应形成薄膜，具有自限性和自饱和性

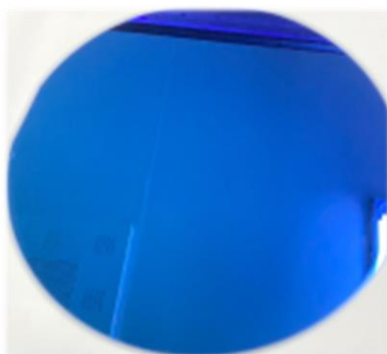
对比



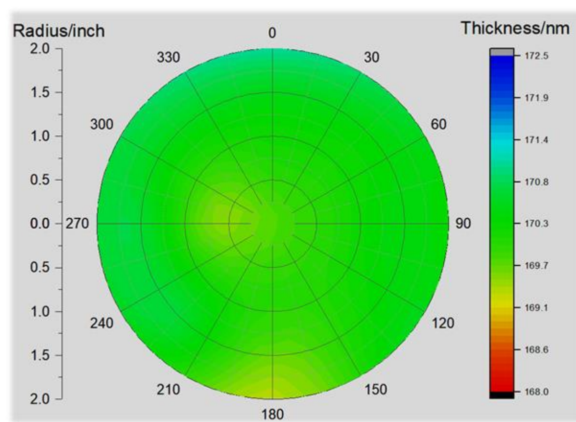
均匀性：椭偏仪测试

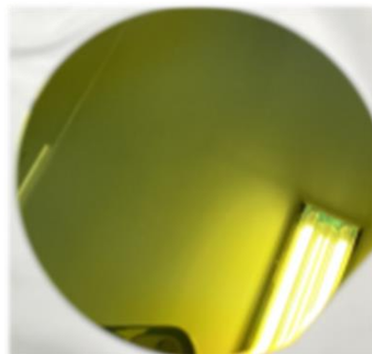
Al2O3





ZnO

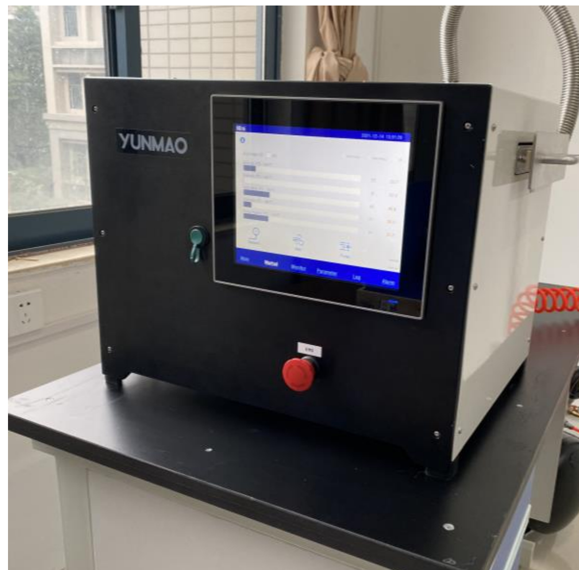




均匀性优异

4寸wafer Uniformity(1σ)<1%

韫茂Mini: Feature



Mini Desktop ALD 技术参数 Technical Specifications （HfO2, ZnO, Al2O3, TiO2等制备）	
特色 Feature	结构紧凑，世界上最小尺寸的桌式ALD World Smallest Footprint Desktop ALD
功能 Function	高端制造，功能强大，操作简易，维护方便
样品最大尺寸	Φ100mm (其他尺寸可定制）硅片或几克粉末
样品反应温度 Heating	RT-300ºC
前驱体 Max Precursor	最大可4组液态或固态反应前驱体, Max 4 Liquid/Solid Precursors，可定制 Can Be Customized
前驱体加热最高温度 Max Precursor Heating	RT-200ºC
包覆均一性 Uniformity	<1% (Al2O3)
成膜速率 Deposition Rate	1Å/Cycle (Al2O3)
臭氧发生器Ozone Generator	可选配，生产效率15g/h
人机界面 HMI	全自动化人机操作界面
安全Safety	工业标准安全互锁Industry Safety Interlock，报警Alarm，EMO